




**FIEL-EFFECT CONTROLLABLE BIPOLAR-TYPE POWER SEMICONDUCTOR
DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD**

Patent number: CN1036666
Publication date: 1989-10-25
Inventor: BAUER FRIED HELM (CH)
Applicant: ASEA BROWN BOVERI (CH)
Classification:
- international: H01L29/72; H01L29/54; H01L29/62
- european:
Application number: CN19890101864 19890222
Priority number(s): CH19880000651 19880222

Also published as:

 EP0332822 (A1)
 US4975782 (A1)
 JP2007570 (A)

Abstract not available for CN1036666

Abstract of corresponding document: **US4975782**

In an IGT (Insulated Gate Transistor), the short-circuiting between the n-type regions (5c) and the p-type regions (4b) of the n-type emitter layer or p-type base layer respectively is produced by a buried conducting layer (12), specifically in the form of a metal silicide layer. Regardless of the spacing between cathode contact (8) and gate (7), the length of the n-type regions (5c) can thereby be reduced to such an extent that latching-up of the component is virtually impossible.

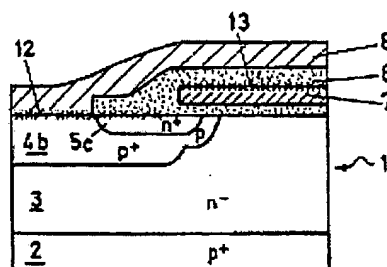


FIG.3D

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

〔19〕中华人民共和国专利局

〔11〕公开号 CN 1036666A



〔12〕发明专利申请公开说明书

〔21〕 申请号 89101864.6

〔51〕 Int.Cl⁴

H01L 29/72

〔43〕 公开日 1989年10月25日

〔22〕申请日 89.2.22

〔30〕优先权

〔32〕88.2.22 〔33〕CH 〔31〕651/88-3

〔71〕申请人 亚瑞亚·勃朗·勃威力有限公司

地址 瑞士巴登

〔72〕发明人 弗里德·海姆·鲍尔

〔74〕专利代理机构 中国专利代理有限公司

代理人 马铁良 肖梅昌

H01L 29/54 H01L 29/62

H01L 29/78 H01L 21/285

H01L 21/60

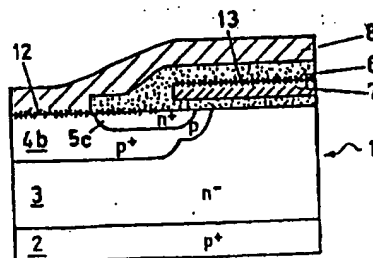
说明书页数: 10 附图页数: 2

〔54〕发明名称 场效应控制的双极型功率半导体器件
及其制造方法

〔57〕摘要

在 IGT(绝缘栅晶体管)中,用埋在结构中的专门的金属硅化物导电层使 n 型区(5c)与 n 型发射层的 P 型区(4b),以及 P 型基极层短路。

n 型区(5c)的长度缩短与阴极接触层(8)和栅极(7)之间的距离无关,使器件实际上不会闭锁。



(BJ)第1456号

1. 场效应控制双极型功率半导体器件, 它包括:

(a) 基片(1)中阳极(A)和阴极(K)之间的一层P型发射层(2), 一层n型基极层(3), 一层P型基极层(4)和一层n型发射层(5), 其中

(aa) P型基极层(4)在横向被彼此隔离的空隙(10)隔离成许多单个的P型区(4a, ..., c);

(bb) 在空隙(10)中n型基极层(3)露在基片(1)的表面; 和

(cc) n型发射层(5)以单个n型区(5a, ..., e)的形式埋入每个P型区(4a, ..., c)中, 因此, P型基极层(4)在P型区(4a, ..., c)的边缘和每一个P型区中的n型区之间露在基片(1)的表面; 和

(d) 阴极边, 栅极—阴极结构交替排列成栅电极(7)和阴极接触层(8), 其中,

(aa) 每个P型区(4a, ..., c)上设置一层阴极接触层(8), 该接触层与P型区所带的所有n型区成电气连接, 并与这些n型区之间的P型区连接; 和

(bb) 在相邻P型区之间的每个空隙(10)上设置用栅绝缘层(6)与基片(1)绝缘的栅电极(7), 栅电极复盖在相邻的P型区的边缘露出在表面上的P型基极层(4);

其特征在于

(o) 制造一层导电层(12)使每一层阴极接触层(8)和所带的n型区之间成电连接, 该导电层在基片(1)表面上从阴极接触

层(8)延伸到所带的n型区。

2. 按权利要求1的器件,其特征在於,在每一个P型区的n型区之间总设置一个P⁺型区,该区从基片(1)的表面穿过P型基极层(4)伸到n型基极层(3)中。

3. 按权利要求1或2的器件,其特征在於,导电层(12)由金属硅化物构成。

4. 按权利要求3的器件,其特征在於,导电层(12)所用的金属是钛、钨、钽和钴中的一种。

5. 按权利要求4的器件,其特征在於,n型区(5a, ..., e)用栅绝缘层(6)完全复盖。

6. 按权利要求5的器件,其特征在於,栅电极(7)用多晶硅制成,并在多晶硅栅电极上设置一层同样的导电层(13)。

7. 制造权利要求1所述器件的方法,在该方法中,首先将基片(1)制成不同的层(2、3、4、5),和区(4a, ..., o; 5a, ..., e),形成栅极(7),并在阴极边完全复盖一层栅绝缘层(6);

其特征在於:

a. a) 除去除栅极(7)下面和边缘范围以外的栅绝缘层(6);

(b) 在基片(1)的露出表面上形成导电层(12);

(c) 在n型区(5a, ..., e)和栅电极(7)上复盖栅绝缘层(6); 和

(d) 紧接着形成阴极接触层。

8. 按权利要求7的方法,其特征在於,栅电极(7)用多晶硅制成,并在基片上形成导电层(12)的同时,也在栅电极(7)上

形成导电层(13)。

9. 按权利要求8的方法, 其特征在于, 为了形成导电层(12、13), 首先选择金属钛、钨、钽和钴中的一种金属沉积在整个表面, 紧接着在热处理中形成相应的金属硅化物。

10. 按权利要求9的方法, 其特征在于:

(a) 用 SiO_2 作栅绝缘层(6);

(b) 首先进行热处理, 在该温度下, 仅在基片(1)的表面和栅电极(7)上, 而不是在栅绝缘层的表面形成硅化物;

(c) 然后除去栅绝缘层(6)表面上的金属; 和

(d) 紧接着在较高的温度下继续热处理。

场效应控制的双极型功率
半导体器件及其制造方法

本发明涉及一种功率半导体器件。特别涉及一种场效应控制双极型功率半导体器件。它包括：

——位于基片中，阳极与阴极之间的P—型发射层、n—型基极层、P—型基极层，和n—型发射层，其中

——P—型基极层，在横向被空隙分隔成彼此隔开的多个单独的P—型区；

——在空隙中，n—型基极层露在基片表面；和

——n—型发射层以单个n—型区形式埋入每个P—型区中，因此，在P—型区(4a、……c)的边缘，和埋入P—型区中的n—型区之间，均是P—型基极层露在基片表面；和

——位于阴极边的，由栅极和阴极接触层交替排列构成的栅极—阴极结构，其中

——每个P—型区上面有一层阴极接触层，该接触层使P—型区所带的全部n—型区成电气连接，并连接这些n—型区之间的P—型区；和

——在相邻的P—型区之间的每一个空隙上设置一个用栅绝缘层与基片绝缘的栅电极，该栅电极在相邻P—型区的边缘，盖住露在表面的P—型基极层。

这样的一种器件已在B. J. Baliga等的文章(IEEE Jnt. Electron Dev. Meet. Tech. Dig., S. 264—267, 1982)中公开了。

本发明还涉及一种制造该器件的方法。按该方法，首先在基片上制出各层，并在阴极边用栅极绝缘层将整个表面复盖。

电源设备，作为电能生产者与用户之间的中间环节，必须用简单方式控制电源开关。

迄今使用的器件，如GTO或功率BJT，其控制费用均非常昂贵。如GTO的断路就要求有高的栅电流，这就需要设置控制电路。

通常，采用带有绝缘控制电极的器件能理想地简化控制电路，例如功率MOSFET。

但是，带有绝缘控制电极的通用器件的缺点在于，器件中单极电流传输取决于高导通电阻。

近来公开的一种新器件，它兼有双极型功率器件和MOS功率器件的优点（参见本文开始引用的B. J. Baliga等的文章，或J. P. Russel等人的文章，IEEE Electron Dev. Lett. EDL-4, S. 63-65 1983）。

IGT（绝缘栅晶体管），或IGR，或COMFET，这些器件的结构，除漏区外，与最新的功率MOSFET器件的结构是一致的。在这种器件中，一个 P^+ 型掺杂的P-型发射区占据了n-型掺杂漏区的位置。

该区的空穴发射由流过绝缘栅下面的，MOS—反型层沟道的电子激励和控制。按这种方式，低功率的控制和电导率的调节在原理上是一致的。

但是，IGT有一个重大缺点，它的结构是按P—n—P—n的顺序排列的四层掺杂层构成的，因此，器件中存在寄生闸流晶体管结构。由于这一原因，正如所报道的那样（参见Nachad等人的文章，

IEEE Trans, Electron Dev, ED-32, S 594—598, 1985), 在临界条件下, IGT 中有阳极电流的闭锁趋势(“latch-up”)。在这种情况下, 电流不受栅极控制, 使器件在短时间内被烧坏。

防止被烧坏的最有效方法是, 设计出消除烧坏过程发生的最佳 IGT 结构。一个重要的原则是, 尽可能减少 n 型区下面的 P 型区中的通路电阻。

例如, 在 B. J. Baliga 的文章中 (IEEE Electron Dev. Lett., EDL-5, S. 323—325, 1984) 已提出, 在每一个 P 型区的 n 型区之间附加一个 P^+ 区, 防止临界情况出现。

虽然采用这种措施使器件出现闭锁时的电流密度明显增大, 但不能完全避免器件闭锁的危险。

本发明的任务是改变 IGT 的结构, 这种结构无论带有附加的 P^+ 区或不带附加的 P^+ 区均能提高闭锁电流密度, 使器件在很大程度上不受闭锁影响。

本发明的任务是用本文一开始所述的方式完成的, 即用一层导电层连接每个阴极接触层, 并同所带的 n 型区之间连接。该导电层在基片表面上穿过阴极接触层和所带的 n 型区之间。

本发明的出发点同样是减小 n 型区下面的通路电阻。企图用缩短 n 型区来降低通路电阻。能实现的 n 型区的最小范围取决于所用工艺。

n 型区的长度 (图 2 中的 X3) 一方面必须足够大, 以确保 n 型区和 P 型区短路, 另一方面, 要根据调整精度使阴极接触层的接触孔和栅电极之间保持最小距离。

就迄今已知的 IGT 结构而言, 在阴极接触层底延伸的 n 型区可

实现的最小长度显然超过2微米。

本发明的核心在于，为确保短路，不再采用一个较长的穿过一个与阴极接触层搭接的大的搭接区的 n 型区，而是在基片表面设置一个特定的短路导电层。按照这种方式， n 型区的长度可以不受上述的最小距离影响而明显缩短。

根据第一个最佳实施例。所说的导电层由金属硅化物构成，所用金属选自钛、钨、钽、和钴金属中的一种金属。采用这种金属硅化物，由于具有较高的电导率，因此接触良好，有高的稳定性和好的工艺兼容性。

根据本发明的另一最佳实施例，栅电极用多晶硅制成，在多晶硅表面同样设置一层金属硅化物导电层。因此这种栅结构的电阻与用单纯多晶硅制成的栅电极电阻相比，降低约1个数量级。从而彻底改善了器件的动态特性。

本发明所述方法的特征工艺步骤如下：

—去掉除栅极下部和边缘区以外的栅极绝缘层；

—将导电层复盖基片的暴露表面；

— n 型区和栅电极再复盖一层栅绝缘层；和

—紧接着形成阴极接触层。

根据本发明所述方法的一个最佳实施例，用多晶硅制成栅极，并在制成的多晶硅栅极上同样形成一层金属硅化物为导电层。首先选择钛、钨、钽、钴系列中的一种金属淀积在栅电极的整个表面，紧接着进行热处理，形成相应的金属硅化物。

本发明的其他实施例用从属权利要求给出。

本发明将结合有关附图用实施例作详细说明。

图1. 现有技术中IGT结构剖面图(部分);

图2. 图1的部分放大图;

图3 A—D. 根据本发明的一个实施例制造IGT的各个步骤。

图1所示的现有技术中IGT结构的一部分, 已在本文开始所述的B. J. Baliga 等人的文章, 或J. P. Kussel 等人的文章中公开。

在这种通用的结构中, 基片1中处于阳极A和阴极K之间的各个掺杂层和它们的范围按层序排列。

各个掺杂层的层序为: 一层 P^+ 掺杂的P—型发射层2, 一层n掺杂的n—型基极层3, 一层P掺杂的P—型基极层4和一层 n^+ 掺杂的n—型发射层5。

P—型基极层4由空隙10分隔成单个的P—型区4a, ……C。在这些空隙10中, 位于下部的n型基极层3在阳极边的基片表面露出。

n型发射层5以单独的n型区5a, ……e的形式埋入每一个P型区4a, ……C中。同时, P型基极层4在P型区4a, ……C的边缘和所带的n型区之间, 在阴极边的基片表面露出。

阴极边的栅极—阴极结构包括交替放置的栅极7和阴极接触层8。在每个P型区4a, ……C上面都有一个阴极接触层8, 该阴极接触层直接与各个P型区中所带的n型区接触, 也与这些n型区之间露在表面的P型区接触。

在每个空隙10上部的基片表面设置栅电极7, 它用普通的栅绝缘层6, 例如 SiO_2 形成的绝缘层与基片电绝缘。栅电极7不仅跨接相应的空隙10, 也跨接相邻的P型区, 在这些空隙中P型基极层

4 露在基片表面。

栅电极 7 与器件的栅极连接。在阳极边，在 P 型发射层 2 上形成平面阳极接触层 11，与阳极 A 相连。

此外，每个 P 型区中的 n 型区之间还可以设置一个 P⁺ 型区 9，该 P⁺ 型区通过 P 型基极层 4 延伸到 n 型基极层 3 中，从而降低器件的闭锁（“latch — up”）趋势。

I GT 的工作机理在此无需进一步研究，它在所引用的文章中有详细说明。

已知的 I GT 结构的缺点从图 2 所示的单个 I GT 结构中可以看到，如本文开始所述，在 n 型区（5c）下面的 P 型区（4b）中的通路电阻，对 I GT 中的寄生间流晶体管的闭锁起关键性作用。通路电阻越小，器件闭锁趋势就越小。

减小导通区（例如，通过 P⁺ 区 9）的电阻率，或缩短通路均能减小通路电阻。

本发明企图缩短通路。n 型区 5c 的长度 X3 对通路长度的确定起决定性作用。

n 型区长度 X3 由所采用工艺确定：在 I GT 中，按现有技术，X3 必须足够大，以确保 n 型区与 P 型基极层短路。这要求 n 型区与阴极接触层的搭接长为 X1（图 2）。

另一方面，由于不可避免的调整精度，必须保证阴极接触层 8 的接触孔与相邻栅电极之间有一个最小距离（图 2 中的长度 X2）。由于有这些先决条件，长度 X2 显然要超过 2 微米，而不会再降低。

当不能用不多的费用来减小长度 X2 时，若按本发明保持长度 X1 和 X2 之间的关系，也就是说使 n 型区无搭接短路，长度 X3 则

会明显下降。

在这种情况下，n型区5c和所带的阴极接触层8之间所必需的电连接是用特制的导电层12（图3D）完成的，导电层在基片表面从n型区5c延伸到阴极接触层8。

导电层12主要由薄层金属硅化物构成，所用金属是钛、钨、钼和钴中的一种。

这种金属硅化物—接触系统已在高度集成化中证明对半导体工艺有兼容性和高稳定性（例如S. J. Lai等的文章所述，IEEE Trans. Electron Dev. ED-33, S. 345—353 1988）。

按此方法，阴极接触层8和栅极绝缘层6下埋设的导电层12使n型区5c与P型区4b短路。从而使长度X3能达到工艺上能实现的那么短。而且至少可以省去搭接长度X1。并使n型区完全被栅极绝缘层6复盖。

若在多晶硅栅电极7表面附加形成另一层同样的导电层13（图3D），则会有更多的优越性。并使较高的栅极电阻明显下降，器件的动态特性会得到明显改善。

此外，导电层12和13很容易在一个单独的工序中制成。

图3A—D描绘了本发明所述方法一个最佳实施例的各个步骤。

从基片1中已预先经过掺杂的情况开始，形成相应的栅电极（用多晶硅制成），并使栅电极的整个表面复盖一层栅绝缘层6（由按LPCVD法气相沉积的SiO₂构成）（图3A）。

本发明与现有技术的差别在于，栅极绝缘层6被各向异性的全平面腐蚀，此时反应离子起蚀刻作用。由于栅电极7的边缘厚度不均匀，

因此在此处留下一个绝缘层边缘区，在栅电极7的下面同样获得绝缘层（图3B）。

现在，在结构的整个表面上蒸发或沉积一层金属，蒸发或沉积的金属与硅形成高温稳定的金属硅化物（参见T. P. Chow等人的文章，IEEE Trans. Electron Dev. ED-30, S. 1480-1497, 1983）。适用的金属有钛、钨、钽和钴。

蒸发或沉积金属之后进行热处理形成金属硅化物，热处理温度应使金属硅化物仅在基片和多晶硅栅电极上形成。而不在栅电极边缘处和 SiO_2 绝缘层的边缘区形成金属硅化物。用湿式化学蚀刻工序除去残留的无用金属。图3C给出了制成的结构。在该结构中导电层12、13用X号标示。

为了使硅化物层有尽可能高的电导率，还应在高温下进一步进行热处理。

紧接着使结构按惯用方法继续加工，在沉积 SiO_2 绝缘层之后在该绝缘层上开一个接触孔，最后制成阴极金属化层（阴极接触层8）（图3D）。

将图2与图3D相比，本发明显然有全面的改善：

——高导电率的导电层12使n型区与P型发射区短路。这表明n型区的长度 X_3 可以做到工艺上允许的那么小。同时避免器件闭锁而具有高稳定性。

——由于导电层12具有高导电率，因而不需要较深的n型区，因此可以增大n型区下面的P型发射层4的垂直范围（图2中的长度 X_4 ）。这同样有利于降低通路电阻。

——带有n型区的多晶硅栅电极，通常规定，也同样有一层电导

率不是特别高的导电层13。栅极电阻可以降低约一个数量级。从而使器件的动态特性有明显改善。

——本发明不仅适用于无 P^+ 区的IGT，也适用于带 P^+ 区的IGT结构。

最后还应特别指出，本发明不仅适用于有所述层序的器件，也适用于具有互补层序的器件，正如J. P. Kussel 等人的文章所述 (IEEE Electron Dev. Lett, EDL-5, S. 437-439, 1984)。在这种情况下，可以用相应的 n 型发射层、 P 型基极层、 n 型基极层、 P 型发射层、 n 型区和 P 型区的层序来取代 P 型发射层、 n 型基极层、 P 型基极层、 n 型发射层、 P 型区和 n 型区的层序。

标 号 说 明

1	基片
2	P 一型发射层
3	n 型基极层
4	P 型基极层
4 a, ..., e	P 型区
5	n 型发射层
5 a, ..., e	n 型区
6	栅绝缘层
7	栅电极
8	阴极接触层
9	P ⁺ 型区
1 0	空隙
1 1	阳极接触层
1 2、1 3	导电层
A	阳极
K	阴极
G	栅极
X 1 ... X 4	长度

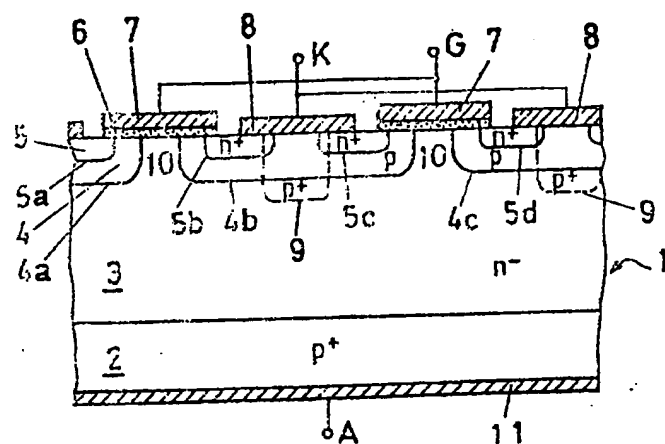


图 1

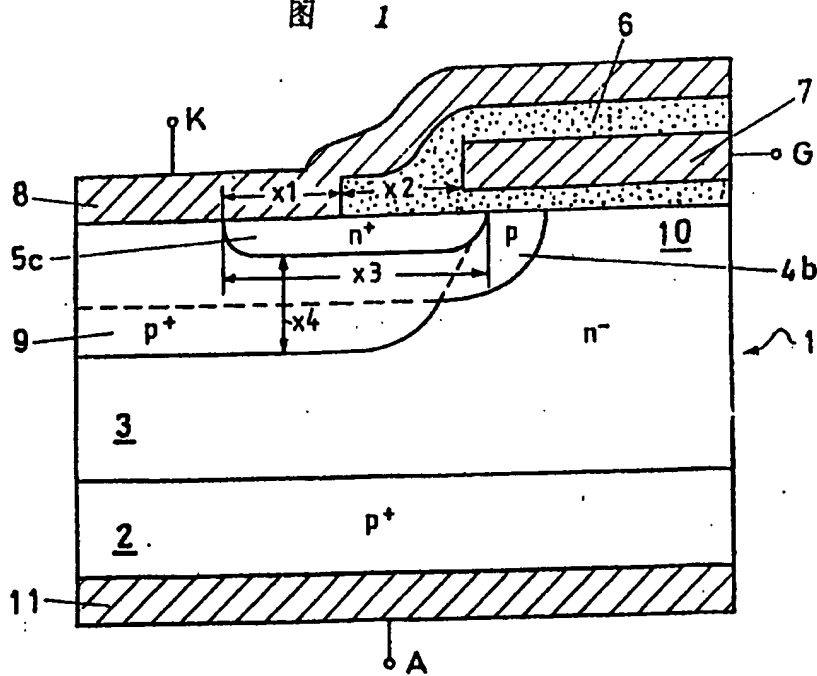


图 2

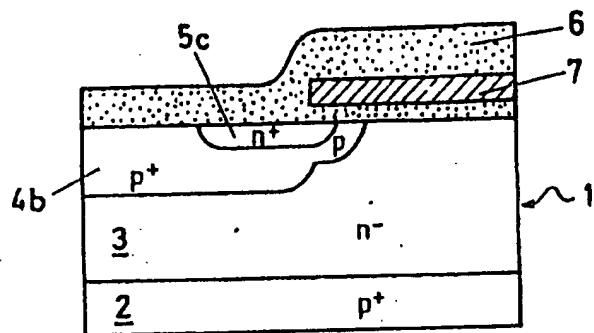


图 3A

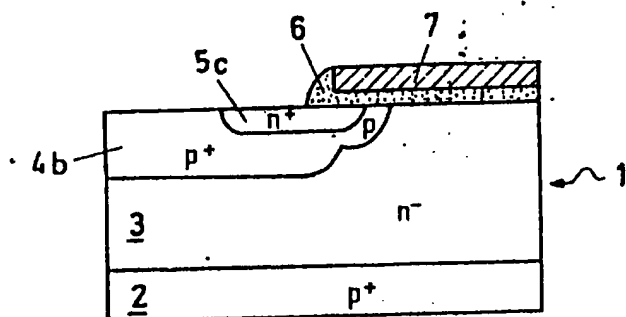


图 3B

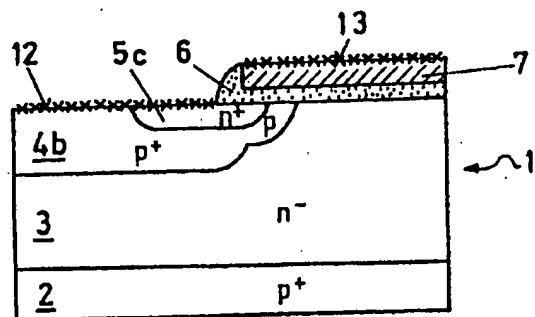


图 3C

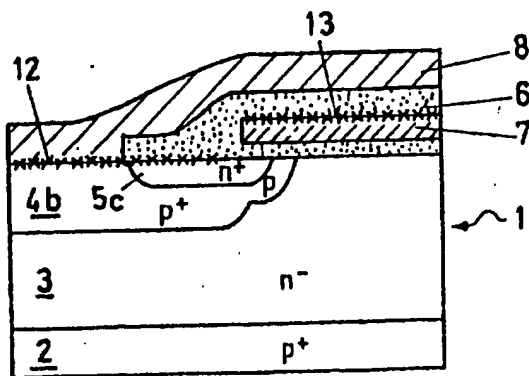


图 3D